

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6032AFDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■概要

ELM4N6032AFDA-N 是 N 沟道低输入电容，低工作电压，低导通电阻的大电流 MOSFET。

■特点

- $V_{ds}=60V$
- $I_d=75A$ ($V_{gs}=10V$)
- $R_{ds(on)} = 8.5m\Omega$ ($V_{gs}=10V$)

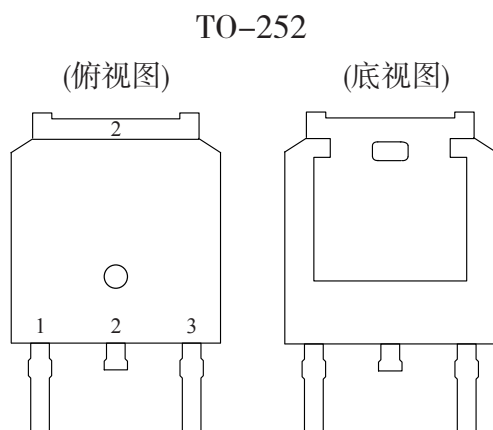
■绝对最大额定值

项目		记号	规格范围	单位	备注
漏极 - 源极电压		V_{ds}	60	V	
栅极 - 源极电压		V_{gs}	± 20	V	
漏极电流 (定常) ($V_{gs}=10V$)	$T_c=25^{\circ}C$	I_d	75	A	1
	$T_c=100^{\circ}C$		47		
脉冲漏极电流		I_{dm}	280	A	2
单脉冲崩溃能量		E_{as}	80	mJ	3
崩溃电流		I_{as}	40	A	
容许功耗	$T_c=25^{\circ}C$	P_d	41	W	4
保存温度范围		T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^{\circ}C$	
结合部温度范围		T_j	$-55 \sim +150$	$^{\circ}C$	

■热特性

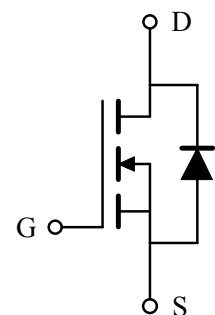
项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
结合部 - 环境热阻	$R_{\theta ja}$	-	62.0	$^{\circ}C/W$	1
接合部 - 外封装热阻	$R_{\theta jc}$	-	1.4		

■引脚配置图



引脚编号	引脚名称
1	GATE
2	DRAIN
3	SOURCE

■电路图



单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6032AFDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■电特性

如没有特别注明时, T_j=25℃

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
静态特性							
漏极 - 源极击穿电压	BV _{dss}	V _{gs} =0V, I _d =250μA	60	-	-	V	
漏极 - 源极导通电阻	R _{ds(on)}	V _{gs} =10V, I _d =20A	-	7.1	8.5	mΩ	2
栅极阈值电压	V _{gs(th)}	V _{gs} =V _{ds} , I _d =250μA	2.2	-	4.5	V	
漏源漏电流	I _{dss}	V _{ds} =48V, V _{gs} =0V	-	-	1	μA	
		V _{ds} =48V, V _{gs} =0V, T _j =55℃	-	-	5		
栅源漏电流	I _{gss}	V _{gs} =±20V, V _{ds} =0V	-	-	±100	nA	
连续电流源	I _s	V _{gs} =V _{ds} =0V, Force current	-	-	75	A	1, 5
二极管正向压降	V _{sd}	V _{gs} =0V, I _s =1A	-	-	1.2	V	2
动态特性							
输入电容	C _{iss}	V _{ds} =30V, V _{gs} =0V, f=1MHz	-	3307	-	pF	
输出电容	C _{oss}		-	201	-	pF	
反馈电容	C _{rss}		-	151	-	pF	
栅极电阻	R _g	V _{ds} =0V, V _{gs} =0V, f=1MHz	-	1.2	-	Ω	
开关特性							
总栅极电荷 (10V)	Q _g	V _{ds} =30V, V _{gs} =10V, I _d =18A	-	57.0	-	nC	
栅极 - 源极电荷	Q _{gs}		-	8.7	-	nC	
栅极 - 漏极电荷	Q _{gd}		-	14.0	-	nC	
导通延迟时间	t _{d(on)}	V _{ds} =30V, V _{gs} =10V R _{gen} =3.3Ω, I _d =20A	-	16.2	-	ns	
导通上升时间	t _r		-	41.2	-	ns	
关闭延迟时间	t _{d(off)}		-	56.4	-	ns	
关闭下降时间	t _f		-	16.2	-	ns	
寄生二极管反向恢复时间	t _{rr}		-	22	-	nS	
寄生二极管反向恢复电荷	Q _{rr}	I _f =20A, di/dt=100A/μs	-	72	-	nC	

备注:

1. 测试值是安装在表面为1平方英寸2盎司铜箔的 FR-4 基板的状态下取得的值;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度≤300μs 和占空比≤2%;
3. E_{as}表示的是最大值。测试条件为V_{dd}=50V, V_{gs}=10V, L=0.1mH, I_{as}=40A;
4. 功耗受150℃结合部温度限制;
5. 数据在理论上是与I_d和I_{dm}相同的,而在实际应用中是会受总功率损耗所限制。

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6032AFDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■ 标准特性和热特性曲线

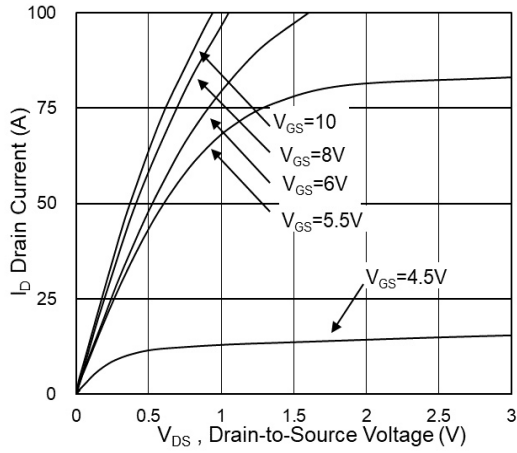


Fig.1 Typical Output Characteristics

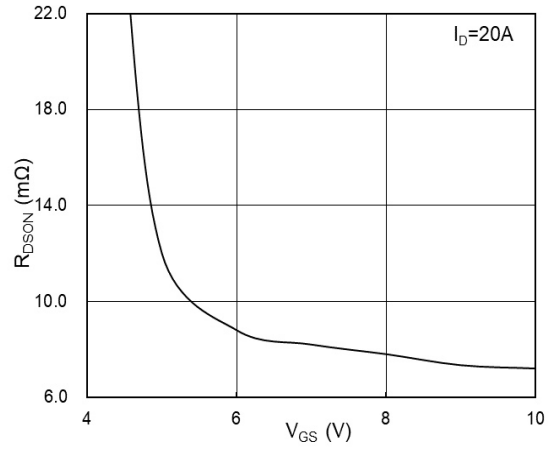


Fig.2 On-Resistance vs G-S Voltage

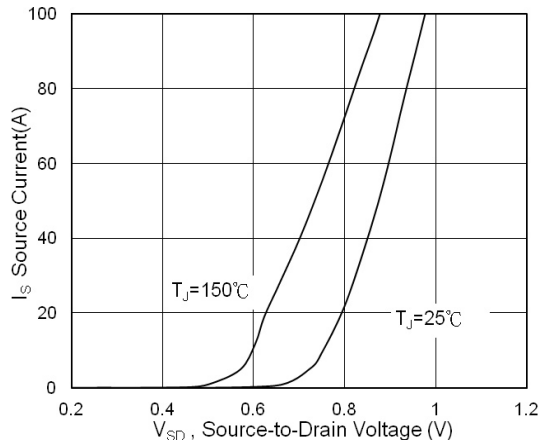


Fig.3 Source Drain Forward Characteristics

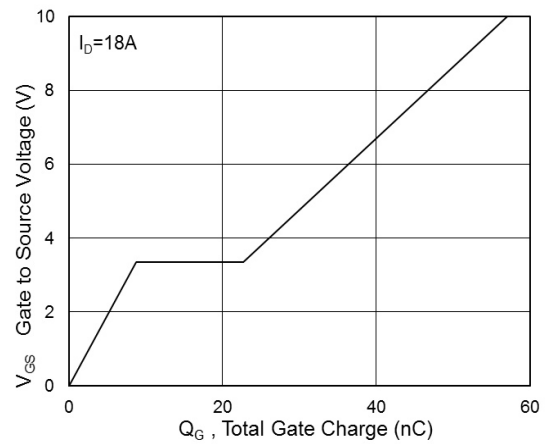


Fig.4 Gate-Charge Characteristics

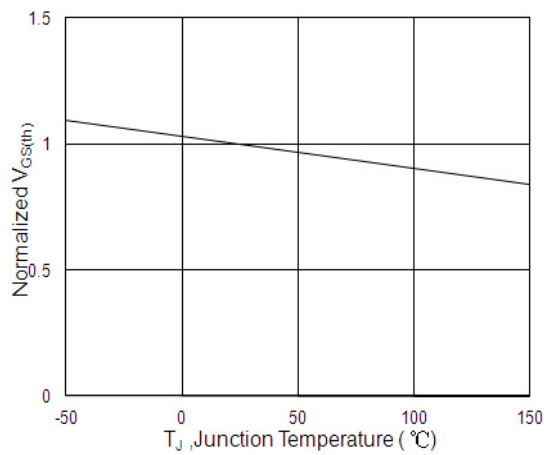


Fig.5 Normalized $V_{GS(th)}$ vs T_J

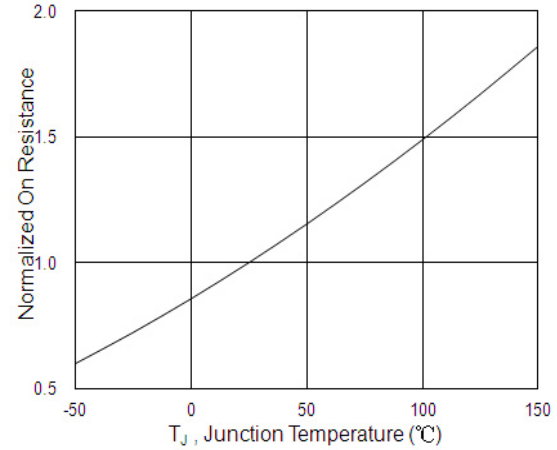


Fig.6 Normalized $R_{DS(on)}$ vs T_J

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6032AFDA-N

<https://www.elm-tech.com>

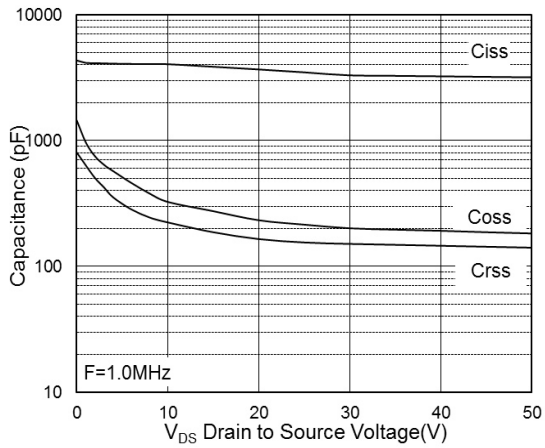


Fig.7 Capacitance

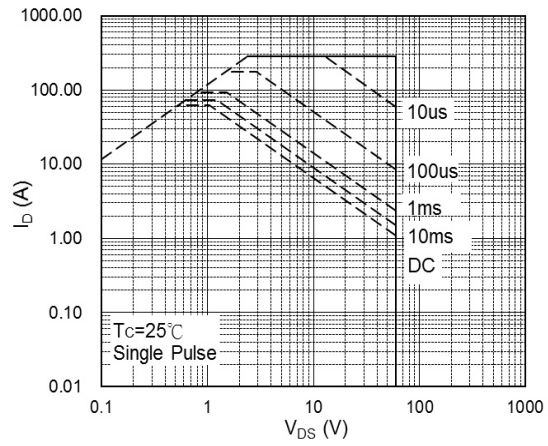


Fig.8 Safe Operating Area

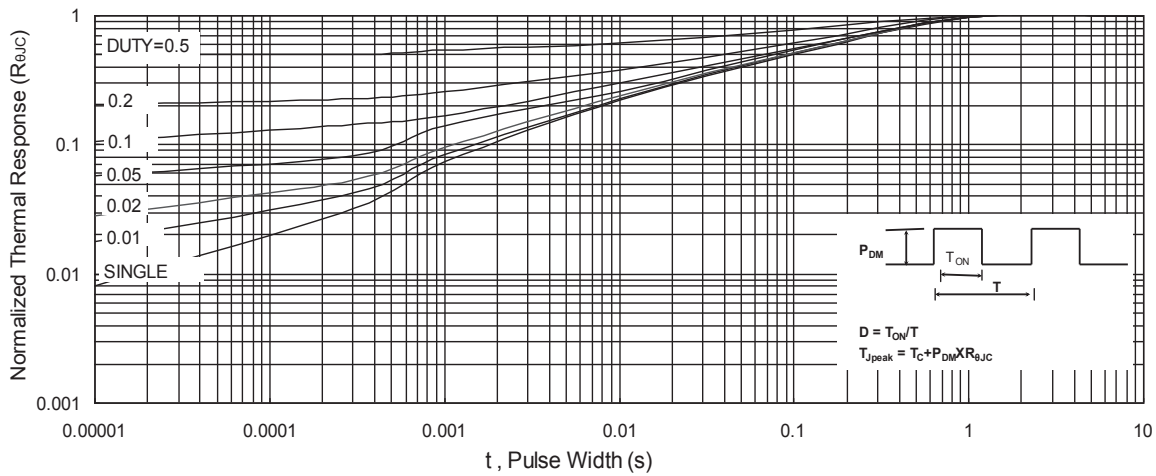


Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

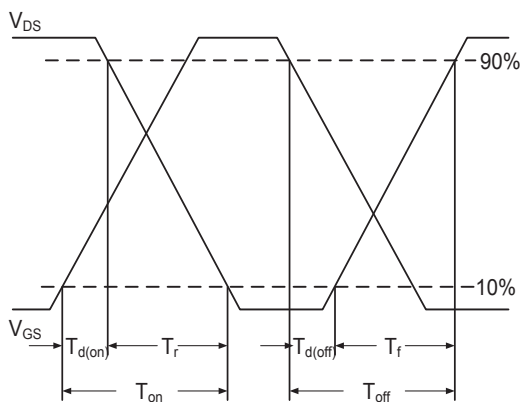


Fig.10 Switching Time Waveform

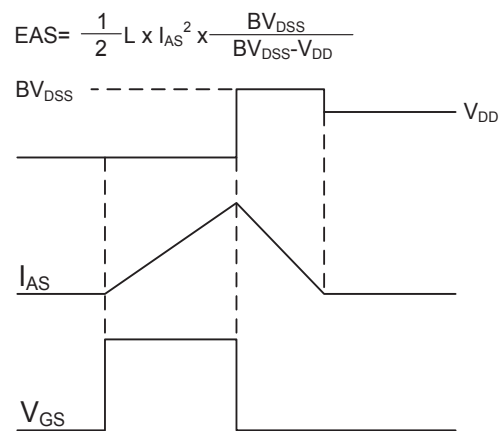


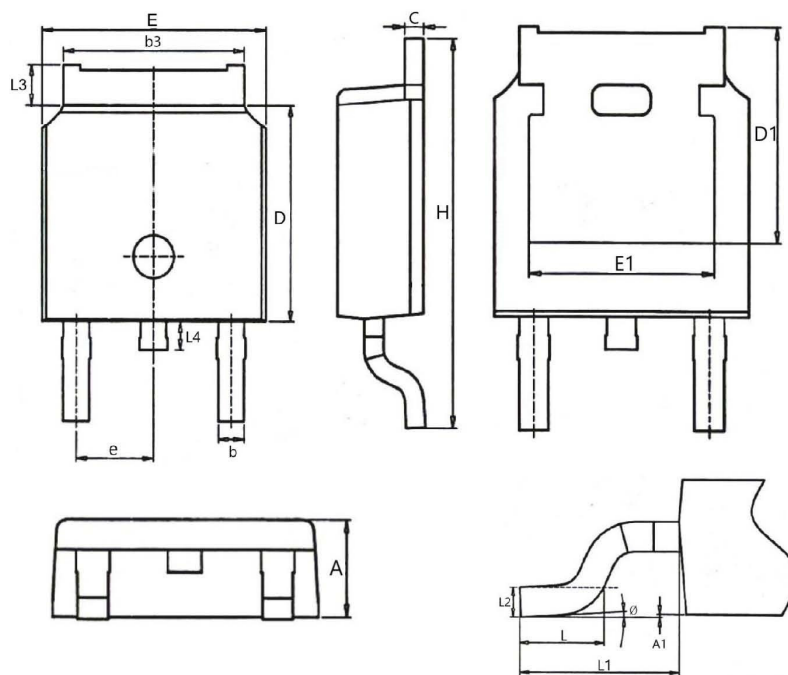
Fig.11 Unclamped Inductive Switching Waveform

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6032AFDA-N

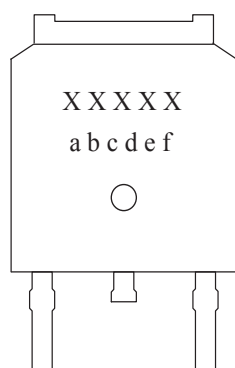
<https://www.elm-tech.com>

TO-252 外形尺寸 (2,500 颗 / 卷)



记号	Millimeters		Inches		记号	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.18	2.40	0.086	0.095	e	2.286BSC		0.09BSC	
A1	---	0.20	---	0.008	H	9.40	10.50	0.370	0.413
b	0.68	0.90	0.026	0.036	L	1.38	1.78	0.054	0.070
b3	4.95	5.46	0.194	0.215	L1	2.90REF		0.114REF	
c	0.43	0.89	0.017	0.035	L2	0.51BSC		0.020BSC	
D	5.97	6.22	0.235	0.245	L3	0.88	1.28	0.034	0.050
D1	5.300REF		0.209REF		L4	0.50	1.00	0.019	0.039
E	6.35	6.73	0.250	0.265	θ	0°	8°	0°	8°
E1	4.32	---	0.170	---					

封装印字说明



记号	表示内容
XXXXX	产品型号代码
a	年份代码: 2019=K, 2020=L, 2021=M ...
b、c	週代码: 01 ~ 53
d、e	批号: 01 ~ 99 或 0A ~ 0Z
f	生产代码: A ~ Z (I、O 除外)